## Новые фазовые превращения под давлением в висмутине

В. В. Бражкин<sup>1)</sup>, Т. И. Дюжева, И. П. Зибров

Институт физики высоких давлений РАН, 142190 Москва, Россия

Поступила в редакцию 9 сентября 2021 г. После переработки 13 сентября 2021 г. Принята к публикации 13 сентября 2021 г.

При исследовании влияния высоких давления (ВД) и температуры (ВТ) на кристаллическую структуру  $Bi_2S_3$  обнаружено, что  $Bi_2S_3$  при p = 6-8 ГПа и T = 625-1050 °С претерпевает химическое разложение по реакции  $Bi_2S_3 \rightarrow BiS_2 + Bi + S$  с образованием  $BiS_2 - I$  ( $a = 15.74 \pm 0.01$  Å;  $b = 4.026 \pm 0.004$  Å;  $c = 11.34 \pm 0.01$  Å;  $\beta = 127.51^\circ$ ;  $D_x = 6.36 \, r/cm^3$ ; V/Z = 71.31 Å<sup>3</sup>), а в области p = 8-8.5 ГПа и  $T \ge 1100-1300$  °С возникает новая метастабильная фаза ВД  $BiS_2 - II$  с симметрией mmm ( $a = 8.45 \pm 0.01$  Å;  $b = 10.26 \pm 0.01$  Å;  $c = 5.87 \pm 0.007$  Å; V/Z = 63.695 Å<sup>3</sup>;  $D_x = 7.12 \, r/cm^3$ ;  $\Delta V/V_0 = 0.11$ ). Фаза  $BiS_2 - II$  в смеси с  $BiS_2 - I$  образуется также на составе Bi + S(1:2) при тех же значениях давления и температуры. Халькогениды состава  $V_2VI_3$  ( $V \equiv As$ , Sb, Bi;  $VI \equiv S$ , Se) демонстрируют явную тенденцию к термодинамической нестабильности с образованием халькогенидов с "неправильной" стехиометрией состава  $VVI_2$ , а, именно,  $AsS_2$ ,  $AsSe_2$ ,  $BiS_2 - I$ ,  $BiS_2 - II$ ,  $BiSe_2$ , но при этом слоистые структуры этих метастабильных фаз ВД различны. Можно предположить, что реакции разложения под давлением на соединения с "неправильной" стехиометрией  $V_2VI_3 \rightarrow VVI_2 + VVI$  и  $V_2VI_3 \rightarrow VVI_2 + V + VI$  являются общей закономерностью.

DOI: 10.31857/S1234567821200064

Сульфид висмута Ві<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (минерал висмутин) относится к большому семейству слоистых халькогенидов  $A_2B_3$  (A  $\equiv$  As, Sb, Bi; B  $\equiv$  S, Se, Te). Интенсивное изучение этих соединений обусловлено их необычными термоэлектрическими свойствами [1-3]. Воздействие давления на кристаллическую структуру может приводить к драматическим изменениям атомной и электронной структур. Вследствие чего возникают такие нетривиальные явления, как электронные топологические переходы, структурные фазовые переходы, металлизация, сверхпроводимость. Кроме того, многие члены этого семейства относятся к простейшим 3d топологическим изоляторам – нового класса материалов, открытие которого является одним из ярких событий физики конденсированного состояния [4-6] и это, по-прежнему, остается "горячей" темой исследований в физике и материаловедении при высоком давлении (ВД). Кроме того, легирование халькогенидов А2В3 приводит к появлению уникальных магнитных свойств топологических изоляторов [7,8].

В нормальных условиях семейство слоистых халькогенидов  $A_2B_3$  образует два структурных класса, что объясняется большим различием размеров ковалентных радиусов атомов металла и халькогеновых атомов. Так, соединения  $Bi_2S_3$ ,

фаза-I(
$$\alpha$$
)  $\xrightarrow{\sim 2\,\%}$  фаза-II( $\beta$ )  $\xrightarrow{\sim 5\,\%}$  фаза-III( $\gamma$ )  $\xrightarrow{\sim 15\,\%}$   
 $\xrightarrow{\sim 15\,\%}$  фаза-IV'( $\sigma$ ') или фаза-IV( $\sigma$ ), (1)

<sup>1)</sup>e-mail: brazhkin@hppi.troitsk.ru

где фаза-I( $\alpha$ ) – исходная фаза  $R\bar{3}m$ , Z = 4; фаза-

Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Sb<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> кристаллизуются в ромбической структуре стибнита  $Sb_2S_3$  (*Pnma*; Z = 4). Соединения  $Bi_2Se_3$ ,  $Bi_2Te_3$ ,  $Sb_2Te_3$  кристаллизуются в гексагональной структуре тетрадимита  $(R\bar{3}m;$ Z = 3), в основе которой лежит 9-слойная плотнейшая упаковка атомов Bi, занимающих 2/3 октаэдров слоями так, чтобы плотноупакованный слой из халькогеновых атомов был общим для двух заполненных Ві октаэдрических слоев. Примечательно, что ромбоэдрические соединения со структурой тетрадимита не обнаруживают фазового перехода в более плотную модификацию стибнита под давлением, за исключением Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>, который принимает эту структуру при одновременном воздействии ВД и высоких температур (BT) [9], а также в результате аморфизации при ВД и комнатной температуре с последующей кристаллизацией в фазу со структурой стибнита [10]. Интенсивное изучение фазовых переходов соединений  $A_2B_3$  различными методами обнаружило целый ряд структурных превращений при ВД [11–16], из анализа которых можно предположить последовательность этих превращений для соединений со структурой тетрадимита:

 $II(\beta)$  – моноклинная C12/m1, Z = 4; фаза-III( $\gamma$ ) – моноклинная C12/c1, Z = 4; фаза-IV( $\sigma$ ) – куб, Z = 2; фаза-IV'( $\sigma'$ ) – новая моноклинная C12/c1, Z = 4 с координационным числом для атомов Bi 9/10 и  $\Delta V/V_0 = 15\%$ . Сразу заметим, что эта последовательность реализуется полностью только для Ві<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> [16] и Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> [10, 11], при этом фазы ВД для этих соединений различны, а для Sb<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> обнаружен лишь один переход в кубическую фазу при 51 ГПа [15]. Структуры новых фаз ВД Ві2Те3; Sb2Te3; Ві2Se3 были предсказаны теоретически с помощью техники "partical swam optimization" [17]. Экспериментальные дифракционные данные, полученные в алмазных камерах ВД, уточнены методом Ритвельда. Достоверность моделей структур может подвергаться сомнению, так как эти моноклинные структуры являются многопараметрическими, а экспериментальный набор дифракционных отражений в алмазных камерах ВД существенно ограничен.

Фазовая диаграмма Bi – S при нормальных условиях содержит лишь одно соединение Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Однако известна почти забытая работа [18], в которой обнаружено существование фазы BiS<sub>2</sub>, полученной при  $p = 4.6 \, \Gamma \Pi a$  и  $T = 1250 \, ^{\circ} C$ . Структура этой фазы определена в работе [19]. В работе [20] изучена сжимаемость BiS<sub>2</sub> до 30 ГПа и обнаружен вялотекущий фазовый переход в фазу с неустановленной структурой при давлениях свыше 35 ГПа. В работе [21] в алмазной камере ВД с лазерным нагревом представлены данные, что Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> претерпевает разложение по реакции  $Bi_2S_3 \rightarrow BiS_2 + BiS$ , которые вызывают некоторое сомнение. При комнатной температуре соединение  $Bi_2S_3$  изучено до 65 ГПа [22, 23]. Установлено, что исходная структура стабильна до 55 ГПа, а дальнейшее увеличение давления приводит к структурному беспорядку или аморфизации.

Цель настоящей работы – исследование структурных превращений и фазовой диаграммы Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> в области давлений до 10 ГПа и температур до 1300 °C. В работе использованы камеры ВД типа "Конак" и "Тороид", позволяющие создавать давление до 9 ГПа и температуру до 2000 °C. При исследовании структурных превращений использовался метод закалки. После 10 ÷ 20-минутной выдержки в условиях высокого давления резко сбрасывалась температура, а затем уменьшалось давление до атмосферного.

Кроме того, в некоторых экспериментах при p = 6-8 ГПа температура уменьшалась в интервале 1300–800 °C со скоростью 4 К/мин, после чего происходила закалка. Исходные образцы помещались в цилиндрический контейнер из горячепрессованного гексагонального нитрида бора. Косвенный нагрев осуществлялся графитовым нагревателем.

Конечные продукты исследовались с помощью камеры Imaging Plate Guinier Camera G670 (Huber  $Cu_{k\alpha 1}$ -излучение), сканирующего микроскопа JEOL JSM 6390 LD и монокристальных камер Лауэ и Бургера.

В экспериментах в качестве исходного образца использовалась стехиометрическая смесь висмута и серы с химической чистотой 99.99 %. Из этой смеси было синтезировано соединение Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> со структурой стибнита с параметрами:  $a = 3.977 \pm 0.006$  Å;  $b = 11.23 \pm 0.02$  Å;  $c = 11.25 \pm 0.06$  Å; V/4 = 125.5 Å<sup>3</sup>;  $D_x = 6.8$  г/см<sup>3</sup>.

Для исследования структурных превращений в  $Bi_2S_3$  была проведена серия экспериментов при  $6\Gamma\Pi a \le p \le 8.5\Gamma\Pi a$ . После вскрытия контейнера образец представлял собой хорошо кристаллизованную массу серебристого цвета с металлическим блеском и размером зерен от 3 до 100 мкм. Образцы, полученные при  $p \sim 8\Gamma\Pi a$  и  $T \sim 800-1300$  °C, содержали монокристаллические включения черного цвета с алмазным блеском и размером 5 ÷ 200 мкм (рис. 1).



Рис. 1. Образец Ві<br/>2S3, полученный при  $p\sim 8\,\Gamma\Pi{\rm a}$ и $T\sim 1300\to 800\,\,^{\circ}{\rm C}$ 

Рентгенофазовый анализ и сканирующая электронная микроскопия образцов выявила, что соединение  $Bi_2S_3$  в условиях ВД и ВТ является неустойчивым и претерпевает химическое разложение с образованием фазы  $BiS_2$  по реакции  $Bi_2S_3 \rightarrow BiS_2+Bi+S$ .

На рисунке 2а представлена микрофотография кристаллов BiS<sub>2</sub>, синтезированных при  $p = 6 \Gamma \Pi a$  и T = 1050 °C. Химический состав: S = 66.3 ± 0.2 ar. %; Bi = 33.7 ± 0.2 ar. %. Образец Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> получен при p == 8 ГПа и T = 1050 °C (рис. 2b). Химический состав:



Рис. 2. Микрофотографии кристаллов  $BiS_2$  (a) и  $Bi_2S_3$  (b). (a) –  $BiS_2$ , полученный при p = 6 ГПа и T = 1050 °С (# 5 из табл. 1). (b) –  $Bi_2S_3$ , полученный при p = 8 ГПа и T = 1050 °С (# 6 из табл. 1)

	#	T (°C)	Состав $+$ *		
	1	500	Нет синтеза		
	2	625	${ m Bi}_2{ m S}_3+{ m Bi}{ m S}_2$		
$p = 6  \Gamma \Pi a$	3	750	${ m Bi_2S_3}+{ m BiS_2}$		
	4	900	${ m Bi_2S_3}+{ m BiS_2}$		
	5	1050	${ m BiS}_2+{ m Bi}_2{ m S}_3$		
	6	1050	${ m BiS}_2+{ m Bi}_2{ m S}_3$		
$p=8{-}8.5\Gamma\Pi\mathrm{a}$	7	1100 $\rightarrow 800~({\rm охл.}~2$ ч)	${ m BiS}_2$ + новая метастабильная фаза		
			$\operatorname{BiS}_2$		
	8	1100 $\rightarrow 830~({\rm охл.}~2$ ч)	${ m BiS}_2$ + новая метастабильная фаза		
			$\operatorname{BiS}_2$		
	9	$1200 \rightarrow 800$ (охл. 1 ч)	${ m BiS}_2$ + новая метастабильная фаза		
			$\operatorname{BiS}_2$		
	10	1300 (охл. 1ч)	${ m BiS}_2$ + новая метастабильная фаза		
			$\operatorname{BiS}_2$		

Таблица 1. Области стабильности  $Bi_2S_3$  и  $BiS_2$ 

\* – линии S и Bi

 $S = 58.5 \pm 0.2$ ат. %;  $Bi = 41.5 \pm 0.2$ ат. %. В таблице 1 приведены области стабильности  $Bi_2S_3$  и  $BiS_2$ .

На рентгенограммах от образцов, полученных закалкой при p = 8-8.5 ГПа и T = 1100-1300 °С, помимо рефлексов от уже известной модификации BiS<sub>2</sub>-I [19,21] ( $a = 15.74 \pm 0.01$  Å;  $b = 4.026 \pm 0.004$  Å;  $c = 11.34 \pm 0.01$  Å;  $\beta = 127.51^{\circ}$ ;  $D_x = 6.36$  г/см<sup>3</sup>; V/Z = 71.31 Å<sup>3</sup>) обнаружена система линий, свидетельствующая об образовании новой метастабильной фазы ВД BiS<sub>2</sub>-II. Для подтверждения этого факта был проведен эксперимент по закалке при p == 8.5 ГПа и T = 1100 °С на составе Bi–S (1:2). На рисунке 3 приведены рентгенограммы от образцов составов Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и BiS<sub>2</sub>.

Совершенно очевидно, что дифрактограммы идентичны и содержат 2 системы линий: одна

Письма в ЖЭТФ том 114 вып. 7-8 2021

принадлежит BiS<sub>2</sub>-I [17, 19], другая – новой метастабильной фазе BД BiS<sub>2</sub>-II.

Изучение монокристаллических сростков черного цвета с металлическим блеском из образцов #8 и #10 (табл. 1) в камере Бургера позволило определить симметрию и параметры ромбической элементарной ячейки  $BiS_2$ -II, уточненных по порошковым данным. В таблице 2 приведены параметры элементарных ячеек  $BiS_2$ -I и  $BiS_2$ -II.

Из слоевых (h0l) и (0kl), полученных в камере Бургера на Мо<sub>k</sub> $_{\alpha}$ -излучении, симметрия фазы BiS<sub>2</sub>-II принадлежит к классу mmm. Однако из-за отсутствия рефлексов (hkl) нельзя однозначно выбрать пространственную группу симметрии. Полное определение атомной структуры фазы BiS<sub>2</sub>-II – предмет следующей публикации.

Состав	р, Т-условия	a (Å)	<i>b</i> (Å)	c (Å)	$\beta$ (град)	$V/8~({ m \AA}^3)$	$\Delta V/V_0$	$D_x~( ho/ m cm^2)$
$BiS_2$ -I	Нормальные	15.7879	4.0361	11.3330	127.562	71.38		6.35
[17]	условия							
$BiS_2$ -I	Нормальные	15.73	4.026	11.34	127.5	71.31		6.36
Наши	условия							
данные								
$BiS_2$ -II	Нормальные	8.45	10.26	5.874		63.70	0.11	7.12
Наши	условия							
данные								

Таблица 2. Параметры элементарных ячеек  $BiS_2$ -I и  $BiS_2$ -II



Рис. 3. Рентгенограммы от образцов составов  $Bi_2S_3$  (1) и  $BiS_2$  (2). 1 – закалка при p = 8 ГПа, T = 1300 °С. 2 – закалка при p = 8.5 ГПа, T = 1100 °С

Следует отметить, что влияние ВД на кристаллическую структуру стибнита Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> из семейства соединений  $V_2VI_3$  (V  $\equiv$  As, Sb, Bi; VI  $\equiv$  S, Se, Te), существенно отличается от того, что экспериментально наблюдается для других членов этого семейства со структурой тетрадимита [11-16], для которых найдена последовательность структурных превращений (1) при ВД, характеризующаяся перманентным моноклинным искажением исходной структуры тетрадимита и последовательным увеличением КЧ с 6 до 10. Для соединения Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> не обнаружено подобных фазовых переходов, а структура стибнита остается устойчивой вплоть до давлений 50-65 ГПа [15-17], при этом на рентгенограммах при  $p \geq 35 \Gamma \Pi a$  линии  $Bi_2S_3$  ослабевают и значительно уширяются, что интерпретируется как изоструктурный переход 2-го рода или рост структурного беспорядка.

В настоящей работе обнаружено, что  ${\rm Bi}_2{\rm S}_3$  при  $p=6{-}8\,\Gamma\Pi{\rm a}$  и  $T=625{-}1050\,^{\circ}{\rm C}$ претерпевает химическое разложение с образованием  ${\rm Bi}{\rm S}_2{\text{-}}{\rm I}$ , а в обла-

сти  $p = 8 - 8.5 \Gamma \Pi$ а и  $T \ge 1100 - 1300 \,^{\circ}\text{C}$  образуется новая метастабильная фаза ВД BiS<sub>2</sub>-II с симметрией *mmm*. Заметим также, что халькогениды V<sub>2</sub>VI<sub>3</sub>  $(V \equiv As, Sb, Bi; VI \equiv S, Se)$  демонстрируют явную тенденцию к термодинамической нестабильности с образованием халькогенидов с "неправильной" стехиометрией состава  $VVI_2$ , а, именно,  $AsS_2$  [24],  $AsSe_2$ [25], BiS<sub>2</sub>-I [19], BiS<sub>2</sub>-II [наши данные], BiSe<sub>2</sub> [19], но при этом слоистые структуры этих метастабильных фаз ВД различны. Можно предположить, что реакции разложения под давлением на соединения с "неправильной" стехиометрией  $V_2VI_3 \rightarrow VVI_2 + VVI_3$ и  $V_2VI_3 \rightarrow VVI_2 + V + VI$  являются общей закономерностью. Это семейство халькогенидов открывает широкие возможности для материаловедения при ВД по поиску новых перспективных материалов, в том числе новых термоэлектрических материалов и новых топологических изоляторов.

Авторы очень признательны сотрудникам Института – Н. Ф. Боровикову, Л. Ф. Куликовой, Л. М. Литягиной, Н. А. Николаеву за помощь в экспериментах при ВД.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ), грант #19-12-00111.

- В. В. Бражкин, А. И. Орлов, Письма в ЖЭТФ 99(5), 325 (2014).
- S. V. Ovsyannikov, V. V. Shchennikov, G. V. Vorontsov, A. Y. Manakov, A. Y. Likhacheva, and V. A. Kulbachinskii, J. Appl. Phys. **104**, 053713 (2008).
- H. Zhang, C.-X. Liu, X.-L. Qi, X. Dai, Z. Fang, and C.-C. Zhang, Nature Phys. 5, 438 (2009).
- 4. J. E. Moore, Nature 464, 194 (2010).
- M. Z. Hasan and C. L. Kane, Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010).
- 6. J. E. Moore and C. L. Kane, PhysicsWorld 24, 32 (2011).
- V. Sakhin, E. Kukovitsky, A. Kiiamov, R. Khasanovc, Yu. Talanova, and G. Teitel'baum, JETP Lett. 109(7), 479 (2019).

- С.О. Фильнов, Ю.А. Сурнин, А.В. Королева, И.И. Климовских, Д.А. Естюнин, А.Ю. Варыхалов, К.А. Бокай, К.А. Кох, О.Е. Терещенко, В.А. Голяшов, Е.В. Шевченко, А.М. Шикин, ЖЭТФ 156(3), 483 (2019).
- Э. А. Атабаева, С. А. Машков, С. В. Попова, Кристаллография 18, 173 (1973).
- J. Zhao, H. Liu, L. Ehm, D. Dong, Z. Chen, and G. Gu, J. Phys. Condens. Matter 25, 125602 (2013).
- Z. Li, W. Yanchao, Lv. Jian, Y. Ma, Y. Cui, and G. Zou, Phys. Rev. Lett. 24, 145501 (2011).
- Y. Ma, G. Linu, P. Zhu, H. Wang, Q. Cui, J. Liu, and Y. Ma, J. Phys. Condens. Matter 24, 475403 (2012).
- S. M. Souza, C. M. Pobbo, D. M. Triches, J. C. de Lima, T. A. Grandi, A. Polian, and M. Gauthier, Physica B 407, 3781 (2012).
- G. Liu, Zhu Li, Y. Ma, Ch. Lin, J. Liu, and Y. Ma, J. Phys. Chem. **117**(19), 10045 (2013).
- I. Efthimiopoulas, J. Zhang, M. Kucway, C. Park, R. C. Ewing, and Y. Wang, Sci. Rep. doi: 10/1038/step 02665.
- Z. Yu, L. Wang, Q. Hu, J. Zhao, S. Yan, K. Yang, S. Sinogeikin, G. Gu, and H.-k. Mao, Sci. Rep. doi: 10.1038/step 15939.

- Y. C. Wang, Lv. Jian, L. Zhu, and Y. Ma, Phys. Rev. B 82, 094116 (2010).
- 18. M.S. Silverman, Inorg. Chem. 3, 1041 (1964).
- A. Yamamoto, D. Hashizume, M.S. Bahramy, and Y. Tokura, Inorg. Chem. **54**(8), 4114 (2015); DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b00349.
- S. M. Kevy, M. B. Nielsen, L. F. Lundegaard, D. Ceresoli, Y.-S. Chen, H. Reardon, P. Parisiades, and M. Bremholm, J. Alloys Compd. 789, 588 (2019); DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.03.023.
- G. Liu, Z. Yu, H. Liu, S. A. T. Redfern, X. Feng, X. Li, Y. Ye, K. Yang, N. Hirao, S. I. Kawaguchi, X. Li, L. Wang, and Y. Ma, J. Phys. Chem. Lett. 9(19), 5785 (2018).
- I. Efthimiopoulos, J. Kemichick, X. Zhou, S. V. Khare, D. Ikuta, and Y. Wang, J. Phys. Chem. A **118**, 1713 (2014).
- C. Li, J. Zhao, Q. Hu, Z. Liu, Z. Yu, and H. Yan, J. Alloys Compd. 688, 329 (2016).
- N.B. Bolotina, V.V. Brazhkin, T.I. Dyuzeva, L.M. Lityagina, L.F. Kulikova, N.A. Nikolaev, and I.A. Verin, Crystallography Reports 58(1), 61 (2013).
- L. M. Lityagina, L. F. Kulikova, I. P. Zibrov, T. I. Dyuzheva, N. A. Nikolaev, and V. V. Brazhkin, J. Alloys Compd. 644, 799 (2015).

8